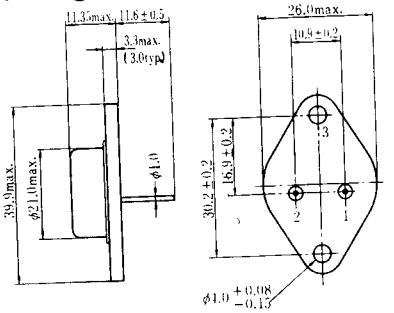
2SD628Ⓗ

シリコン NPNエピタキシャル形

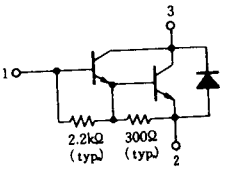
低周波電力増幅用，大電流スイッチング用
2SB638Ⓗとコンプリメンタリペア

SILICON NPN EPITAXIAL

LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER
HIGH CURRENT SWITCHING
Complementary pair with 2SB638Ⓗ



1. ベース：Base
2. エミッタ：Emitter
3. コレクタ：Collector
(ケース) (Case)
(Dimensions in mm)



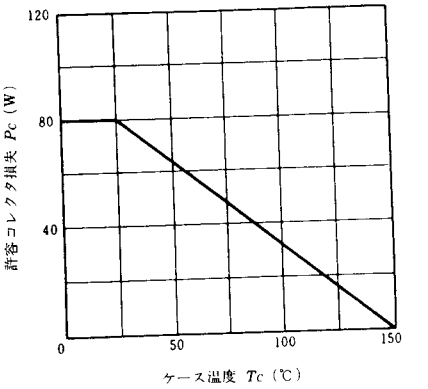
(JEDEC TO-3)

■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃)

項目	Symbol	2SD628Ⓗ	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	100	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	100	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	7	V
コレクタ電流	I_C	10	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(peak)}$	15	A
ベース電流	I_B	2	A
許容コレクタ損失	P_C*	80	W
接合部温度	T_j	150	℃
保存温度	T_{stg}	−65～+150	℃

* T_C=25℃における許容値
* Value at T_C=25℃

許容コレクタ損失のケース温度による変化
MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃)

項目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・エミッタ維持電圧	$V_{CEO(sus)}$	I_C=200mA, R_{BE}=∞*	100	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	I_E=50mA, I_C=0	7	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	V_{CB}=100V, I_E=0	—	—	100	μA
	I_{CEO}	V_{CE}=80V, R_{BE}=∞	—	—	1.0	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	V_{CE}=3V, I_C=5A*	1000	—	20000	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)(1)}$	I_C=5A, I_B=10mA*	—	—	2.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)(1)}$		—	—	2.0	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)(2)}$	I_C=10A, I_B=100mA*	—	—	3.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)(2)}$		—	—	3.5	V
ターンオン時間	t_{on}	I_C=5A, I_{B1}=−I_{B2}=10mA	—	2	—	μs
ターンオフ時間	t_{off}		—	8	—	μs

* パルス測定
* Pulse Test